
	<p><b>SI7450DP-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7450DP-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 3.2A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI7450DP-T1-E3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19670 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7450DP-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.2A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19670 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI7450DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7450DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7450DP-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7450DP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI7450DP-T1</b> VISHAY VISHAY QFN8	 <b>SI7450DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 3.2A PPAK SO-8	 <b>SI7450DP.</b> VIS SI7450DP. VIS	 <b>SI7450DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 3.2A PPAK SO-8
 <b>SI7450DP</b> SI SI7450DP SI	 <b>SI7450DP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay N-CHANNEL 200-V (D-S) MOSFET	 <b>SI7451DP-T1</b> Vishay Precision Group SI7451DP-T1 VISHAY	 <b>SI7450DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 3.2A PPAK SO-8

heiße Teile

Mehr

- |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ⊛ SI7445DP-T1-GE3  | ↔ SI7445DP-T1-GE3  | ➔ SI7446BDP        | D SI7446BDP-T1-E3  | ➔ SI7446BDP-T1-E3  |
| ⊣ SI7446BDP-T1-GE3 | ⊛ SI7446BDP-T1-GE3 | D SI7446BDP-T1-T3  | ➔ SI7446DP         | ➔ SI7446DP-T1      |
| ⊛ SI7446DP-T1-GE3  | ⊣ SI7446DP-T1.     | ⊛ SI7447ADP        | ↔ SI7447ADP-T1-E3  | ➔ SI7447ADP-T1-E3  |
| D SI7447ADP-T1-GE3 | ⊛ SI7447ADP-T1-GE3 | ⊣ SI7447DP-T1-GE3  | ⊛ SI7448DP         | ➔ SI7448DP-T1-E3   |
| ➔ SI7448DP-T1-E3   | ↔ SI7448DP-T1-GE3  | ⊛ SI7448DP-T1-GE3  | ⊣ SI7450DP         | ➔ SI7450DP-T1-E3   |
| ↔ SI7450DP-T1-GE3  | ➔ SI7450DP-T1-GE3  | D SI7452DP-T1-E3   | ⊛ SI7452DP-T1-E3   | ⊣ SI7452DP-T1-GE3  |
| ⊛ SI7452DP-T1-GE3  | D SI7454CDP-T1-GE3 | ➔ SI7454CDP-T1-GE3 | ↔ SI7454DDP-T1-GE3 | ➔ SI7454DDP-T1-GE3 |
| ⊣ SI7454DP         | ⊛ SI7454DP-T1-E3   | ↔ SI7454DP-T1-E3   | ➔ SI7454DP-T1-GE3  | ➔ SI7454DP-T1-GE3  |
| ⊛ SI7456CDP-T1-GE3 | ⊣ SI7456CDP-T1-GE3 | ⊛ SI7456DDP-T1-GE3 | D SI7456DDP-T1-GE3 | ➔ SI7456DP         |
| ↔ SI7456DP-T1-E3   | ⊛ SI7456DP-T1-E3   | ⊣ SI7456DP-T1-GE3  | ⊛ SI7456DP-T1-GE3  | ➔ SI7458DP-T1-E3   |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited